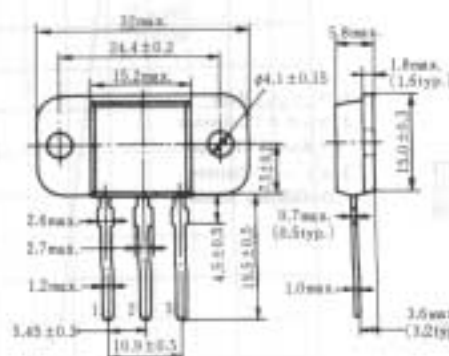


2SC2615

シリコン NPN 三重拡散形
高電圧高速度大電力スイッチング用

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED
HIGH VOLTAGE, HIGH SPEED AND HIGH POWER
SWITCHING



1. ベース: Base
2. コレクタ: Collector
(マウンティング) (Flange)
3. エミッタ: Emitter
(Dimensions in mm)

(HPAK)

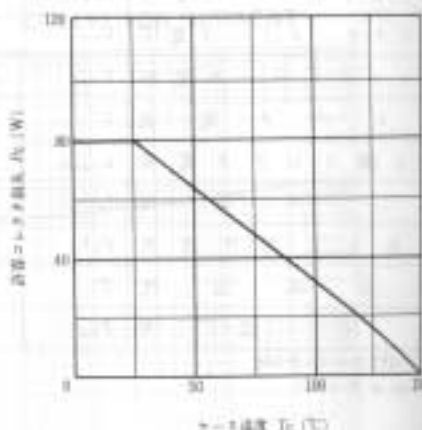
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	2SC2615	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	500	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	400	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	7	V
コレクタ電流	I_C	8	A
せん頭コレクタ電流	$I_{C(sat)}$	16	A
ベース電流	I_B	4	A
許容コレクタ損失	P_C	80	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55—+150	$^\circ\text{C}$

※ $T_c = 25^\circ\text{C}$ における許容値

※ Value at $T_c = 25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項 目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CE0(sat)}$	$I_C = 0.2\text{A}, R_{BE} = \infty, L = 100\text{mH}$	400	—	—	V
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CE0(sat)}$	$I_C = 8\text{A}, I_{B1} = 1.6\text{A}, -I_{E1} = 0.8\text{A}$ $V_{BE} = -5\text{V}, L = 180\text{ }\mu\text{H}, \text{Clamped}$	400	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EB0}$	$I_E = 10\text{mA}, I_C = 0$	7	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CB0}	$V_{CB} = 400\text{V}, I_E = 0$	—	—	100	μA
コレクタ遮断電流	I_{CE0}	$V_{CE} = 350\text{V}, R_{BE} = \infty$	—	—	100	μA
直流電流増幅率	h_{FE1}	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 4\text{A}^*$	15	—	—	
直流電流増幅率	h_{FE2}	$V_{CE} = 5\text{V}, I_C = 8\text{A}^*$	7	—	—	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 4\text{A}, I_B = 0.8\text{A}^*$	—	—	1.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 4\text{A}, I_B = 0.8\text{A}^*$	—	—	1.5	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = 8\text{A}, I_{B1} = -I_{B2} = 1.6\text{A}, V_{CE} = 150\text{V}$	—	—	1.0	μs
蓄積時間	t_{stg}		—	1.2	2.5	μs
下降時間	t_f		—	—	1.0	μs

※ パルス測定

※ Pulse Test